
	<h2>SI3585DV-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3585DV-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N/P-CH 20V 2A 6-TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3585DV-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 58620 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3585DV-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 20V 2A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	58620 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	830mW
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2A, 1.5A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	125 mOhm @ 2.4A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	600mV @ 250µA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	3.2nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)





















SI3585DV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3585DV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3585DV-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3585DV-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 SI3585DV VISHAY SI3585DV VISHAY	 SI3585CDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 3.9A 6TSOP	 SI3585DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 2A 6- TSOP	 SI3585DV-T1 VISHAY SI3585DV-T1 VISHAY
 SI3585DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 2A 6- TSOP	 SI3585DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 2A 6- TSOP	 SI3586DV VISHAY SI3586DV VISHAY	 SI3586DS-T1-E3 VISHAY VISHAY SOT-23

heiße Teile

Mehr

 SI3493DV-T1-GE3	 SI3495DV	 SI3495DV-T1-E3	 SI3495DV-T1-E3	 SI3495DV-T1-GE3
 SI3495DV-T1-GE3	 SI3499DV-T1-E3	 SI3499DV-T1-E3	 SI3499DV-T1-GE3	 SI3499DV-T1-GE3
 SI3500-A-GM	 SI3529DV-T1-GE3	 SI3529DV-T1-GE3	 SI3552DV	 SI3552DV-T1
 SI3552DV-T1-E3	 SI3552DV-T1-E3	 SI3552DV-T1-GE3	 SI3552DV-T1-GE3	 SI3585CDV
 SI3585CDV-T1-GE3	 SI3585CDV-T1-GE3	 SI3585DV	 SI3585DV-T1	 SI3585DV-T1-E3
 SI3585DV-T1-GE3	 SI3585DV-T1-GE3	 SI3586DS-T1-E3	 SI3586DV	 SI3586DV-T1-E3
 SI3586DV-T1-E3	 SI3586DV-T1-GE3	 SI3586DV-T1-GE3	 SI3588DV	 SI3588DV-T1-E3
 SI3588DV-T1-E3	 SI3588DV-T1-GE3	 SI3588DV-T1-GE3	 SI3590DV-T1-GE3	 SI3590DV-T1-GE3
 SI3801DV-T1	 SI3803DV-T1	 SI3805DV-T1	 SI3805DV-T1-E3	 SI3805DV-T1-E3
 SI3812DV-T1-GE3	 SI3812DV-T1-GE3	 SI3850ADV-T1-E3	 SI3850ADV-T1-E3	 SI3850ADV-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited